



РФЯЦ-ВНИИТФ
РОСАТОМ

Расчёты скорости обмена энергией между электронами и ионами на основе модели среднего атома Старретта и Саумона

А.А. Овчинин, Н.А. Смирнов, П.А. Лобода, А.Л. Фальков

РФЯЦ – ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина

Релаксация импульса и энергии электронов в твёрдом теле и в жидкости/плазме



Электропроводность,
теплопроводность

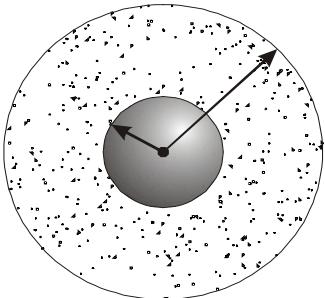
Выравнивание температуры в
неравновесно нагретом веществе

$$\frac{\partial E_e}{\partial t} = -G (T_e - T_i)$$

коэффициент электрон-фононного/электрон-
ионного обмена

- Взаимодействие лазерного излучения с веществом: $T_e > T_i$
- Термоядерный синтез: $T_i > T_e$

Модели среднего атома



- Приближение сферической симметрии
- Приближение самосогласованного поля

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V(r) \right) \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r})$$

$$V(r) = V_{\text{el}}(r) + V_{\text{xc}}(r)$$

$$\nabla^2 V_{\text{el}}(r) = -4\pi e^2 (n_e(r) - n_i(r))$$

$$n_e(r) = \sum_i f(\varepsilon_i) |\psi_i(\mathbf{r})|^2$$

- Статистика Ферми-Дирака

$$f(\varepsilon) = \{1 + \exp [\beta_e (\varepsilon - \mu_e)]\}^{-1}, \quad \beta_e = 1/T_e$$

Модели применимы в широком диапазоне T и ρ , охватывающем состояния горячего и тёплого плотного вещества

$T_e > \theta_D$ (θ_D – температура Дебая)  рассеяние электронов можно считать упругим

$$T_i > \theta_D$$

$$G = \pi \hbar \beta_e n_i \int P^{(1)}(\varepsilon) f(\varepsilon, \mu_e) [1 - f(\varepsilon, \mu_e)] d\varepsilon$$

$$P^{(1)}(\varepsilon) = \frac{4}{\hbar} \sum_{\mathbf{k},i;\mathbf{k}',j;\nu} \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu} \delta(\varepsilon_{\mathbf{k},i} - \varepsilon) \delta(\varepsilon_{\mathbf{k}',j} - \varepsilon) \left| \mathcal{G}_{\mathbf{k},i;\mathbf{k}',j}^{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu} \right|^2$$

$\mathbf{K} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$ – приращение волнового вектора электрона, n_i – средняя концентрация ионов

$\mathbf{q}(\mathbf{K}) = \mathbf{K} - \mathbf{g}$ – волновой вектор фонона, приведённый к 1-й зоне Бриллюэна

\mathbf{g} – вектор обратной решётки

ν , $\omega_{\mathbf{q},\nu}$ – поляризация и частота фонона

$\mathcal{G}_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}^{\mathbf{q},\nu}$ – матричный элемент электрон-фононного взаимодействия

Коэффициент электрон-фононного обмена в твёрдом теле.

Обобщённый метод Аллена [1,2]

Маффин-тин приближение

$$V_e(r) = \begin{cases} V(|\mathbf{r} - \mathbf{R}_i|) & \text{при } |\mathbf{r} - \mathbf{R}_i| \leq a, \\ 0 & \text{при } \min_j |\mathbf{r} - \mathbf{R}_j| > a. \end{cases}$$



В случае одного
рассеивающего центра [3]

$$P^{(1)}(\varepsilon) = \frac{4m_e^2 \varepsilon^2 \sigma_{\text{tr}}^{(1)}(\varepsilon)}{\pi^3 \hbar^4 M_i}$$

транспортное сечение e-i рассеяния в
сферически-симметричном потенциале $V(r)$

$$\sigma_{\text{tr}}^{(1)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega} = \frac{2\pi \hbar^2}{m_e \varepsilon} \sum_{l=0}^{\infty} \sin^2 (\delta_{l+1}(\varepsilon) - \delta_l(\varepsilon))$$

Формула (1)

- может использоваться для расчётов коэффициента электрон-ионного обмена в плазме на основе моделей среднего атома
- была ранее получена при помощи
 - соотношения Кубо [4]
 - квантового кинетического уравнения

Больцмана [5]

1. P.B. Allen. Phys. Rev. Lett. 59, 1460 – 1463 (1987).
2. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B 101, 094103 (2020).
3. G.D. Gaspari, B.L. Gyorffy. Phys. Rev. Lett. 28, 801 – 805 (1972).
4. J. Daligault, J. Simoni. Phys. Rev. E 100, 043201 (2019).
5. S. Rightley, S.D. Baalrud. Phys. Rev. E 103, 063206 (2021).

$$\bar{Z} = \frac{\sqrt{2} m_e^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3 \beta_e^{3/2} n_i} I_{1/2}(\beta_e \mu_e), \quad I_k(x) = \int_0^{\infty} \frac{y^k dy}{1 + \exp(y - x)}$$

↑
средний заряд иона

Коэффициент электроно-
фононного обмена в
твёрдом теле (обобщённый
метод Аллена)



Приближение
сферической
симметрии



Коэффициент электроно-
ионного обмена в плазме
на основе модели
среднего атома

Можно получить согласованные
широкодиапазонные зависимости $G(\rho, T_e, T_i)$,
используя результаты твердотельных расчётов
при низких T_e, T_i (до нескольких эВ) и расчётов по
моделям среднего атома при более высоких T_e, T_i

Удельное электрическое сопротивление в твёрдом теле. Метод Аллена для решения уравнения Больцмана [1,2]



$T_e > \theta_D$  рассеяние электронов можно считать упругим

$$\eta = \frac{3\pi \hbar M_i \beta_e}{e^2 m_e^2 n_i} \int d\varepsilon \frac{f(\varepsilon) [1 - f(\varepsilon)] P^{(2)}(\varepsilon)}{[w(\varepsilon) v^2(\varepsilon)]^2}$$

$$P^{(2)}(\varepsilon) = \frac{4}{\hbar} \sum_{\mathbf{k},i;\mathbf{k}',j;\nu} \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu} \delta(\varepsilon_{\mathbf{k},i} - \varepsilon) \delta(\varepsilon_{\mathbf{k}',j} - \varepsilon) \left| \mathcal{G}_{\mathbf{k},i;\mathbf{k}',j}^{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu} \right|^2 S_{ii}^{(1)}(K)$$

$$S_{ii}^{(1)}(K) = \frac{\hbar K^2 [2n_B(\beta_i \hbar \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu}) + 1]}{2M_i \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu}} \approx \frac{\hbar}{2M_i} \sum_{\nu'} \frac{(\mathbf{K} \mathbf{e}_{\nu'})^2}{\omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu'}} [2n_B(\beta_i \hbar \omega_{\mathbf{q}(\mathbf{K}),\nu'}) + 1]$$

$n_B(x) = [\exp(x) - 1]^{-1}$, $\beta_i = 1/T_i$, $w(\varepsilon)$ – плотность состояний электронов

$S_{ii}^{(1)}(K)$ – эффективный ион-ионный структурный фактор (без учёта слагаемого, отвечающего брэгговскому рассеянию), в однофононном приближении

1. P.B. Allen. Phys. Rev. B 17, 3725 – 3734 (1978).

2. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B 106, 024109 (2022).

3. D.A. Baiko, A.D. Kaminker, A.Y. Potekhin, D.G. Yakovlev. Phys. Rev. Lett. 81, 5556 – 5559 (1998).

Удельное электрическое сопротивление в твёрдом теле. Метод Аллена для решения уравнения Больцмана [1,2]



- Приближение однородного газа свободных электронов

$$w(\varepsilon) = \sqrt{2\varepsilon} m_e^{3/2} / (\pi^2 \hbar^3 n_i), \quad v(\varepsilon) = \sqrt{2m_e \varepsilon}$$

- Случай сильного вырождения электронов

$$T_e \lesssim E_F \Rightarrow \varepsilon \approx \mu_e, \quad w(\varepsilon) v^2(\varepsilon) \approx 3\bar{Z}/m_e$$

- Маффин-тин приближение + один рассеивающий центр [3]

$P^{(2)}(\varepsilon)$ отличается от $P^{(1)}(\varepsilon)$ в выражении для G только наличием под знаком суммы множителя $S^{(1)}(K)$

$$P^{(2)}(\varepsilon) = \frac{4m_e^2 \varepsilon^2 \sigma_{\text{tr}}^{(2)}(\varepsilon)}{\pi^3 \hbar^4 M_i}, \quad \sigma_{\text{tr}}^{(2)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) S_{ii}^{(1)}(K) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega}, \quad K = 2\sqrt{m_e \varepsilon (1 - \cos \theta)}/\hbar$$

$$\eta = \frac{m_e \nu_{ei}^{(2)}}{\bar{Z} n_i e^2}, \quad \nu_{ei}^{(2)} = \frac{4m_e \beta_e}{3\pi^2 \hbar^3 \bar{Z}} \int_0^\infty \varepsilon^2 f(\varepsilon) [1 - f(\varepsilon)] \sigma_{\text{tr}}^{(2)}(\varepsilon) d\varepsilon$$

Обобщённая формула
Займана (используется
в расчётах по моделям
среднего атома [4])

1. P.B. Allen. Phys. Rev. B 17, 3725 – 3734 (1978).
2. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B 106, 024109 (2022).
3. G.D. Gaspari, B.L. Gyorffy. Phys. Rev. Lett. 28, 801 – 805 (1972).
4. P.A. Sterne, S.B. Hansen, B.G. Wilson, W.A. Isaacs. HEDP 3, 278 – 282 (2007).

Методы расчёта коэффициента электрон-фононного обмена и электрического сопротивления в твёрдом теле



Приближение сферической симметрии

Методы расчёта

коэффициента электрон-ионного обмена

и

электрического сопротивления

в плазме на основе модели среднего атома

$$G = 3\bar{Z} n_i m_e \nu_{ei}^{(1)} / M_i$$

$$\nu_{ei}^{(1,2)} = \frac{4m_e \beta_e}{3\pi^2 \hbar^3 \bar{Z}} \int_0^{\infty} \varepsilon^2 f(\varepsilon) [1 - f(\varepsilon)] \sigma_{tr}^{(1,2)}(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$\sigma_{tr}^{(1)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega}$$

$$\eta = m_e \nu_{ei}^{(2)} / (\bar{Z} n_i e^2)$$

Нет ионного структурного фактора
(описывает передачу энергии, не связанную с макроскопическим потоком частиц; направление движения рассеянного электрона не играет роли)

$$\sigma_{tr}^{(2)}(\varepsilon) = \int d\Omega (1 - \cos \theta) S(K) \frac{d\sigma(\varepsilon, \theta)}{d\Omega}$$

Есть ионный структурный фактор
(описывает релаксацию импульса, не связанную с макроскопическим потоком электронов; направление движения рассеянного электрона играет роль)

- Вещество – совокупность псевдоатомов
- Псевдоатом: ион (центральное ядро + связанные электроны) и экранирующие его свободные электроны

Рассеивающий потенциал

Потенциал $V^{PA}(r)$, создаваемый
отдельным псевдоатомом

- Слабо зависит от T_i , что согласуется с
обобщённым формализмом Аллена для
твёрдого тела и с диэлектрическим
формализмом Далиго и Димонте [3]

Потенциал $V^{MF}(r)$, создаваемый
совокупностью всех псевдоатомов [4]

- Более чувствителен к T_i , чем $V^{PA}(r)$

Какой потенциал правильнее использовать?

1. C.E. Starrett, D. Saumon. *HEDP* 10, 35 – 42 (2014).
2. Z.A. Johnson, N. Shaffer, M.S. Murillo. *arXiv:2411.02363v1* (2024).
3. J. Daligault, G. Dimonte. *Phys. Rev. E* 79, 056403 (2009).
4. C.E. Starrett. *HEDP* 25, 8 – 14 (2017).

Диэлектрический формализм Далиго и Димонте для коэффициента электрон-ионного обмена [1]



$$G = 3\langle Z \rangle n_i m_e \nu_{ei} / M_i, \quad \nu_{ei} = 4\sqrt{2\pi} \langle Z \rangle^2 e^4 n_i \ln \Lambda / (3\sqrt{m_e} T_e^{3/2})$$

$$\ln \Lambda = \frac{\sqrt{\pi}}{2\langle Z \rangle I_{1/2}(\beta_e \mu_e)} \int_0^\infty dk \frac{\tilde{n}_e^{\text{scr}}(k)}{\varkappa^2 [k^2 + \varkappa^2 (1 - G_{ee}(k))]} f\left(\frac{\hbar^2 k^2}{8m_e}\right)$$

$$\tilde{n}_e^{\text{scr}}(k) = \frac{4\pi}{k} \int_0^\infty r n_e^{\text{scr}}(r) \sin(kr) dr, \quad n_e^{\text{scr}}(r) - \text{плотность свободных электронов псевдоатома}$$

$G_{ee}(k)$ – локальная электрон-электронная полевая поправка [2]

$\varkappa^2 = -4\pi e^2 \chi_e^0(k)$, $\chi_e^0(k)$ – статическая функция отклика невзаимодействующих электронов [3]

$$\langle Z \rangle = 4\pi \int_0^\infty n_e^{\text{scr}}(r) r^2 dr - \text{средний заряд иона (при высоких } T_e \langle Z \rangle \approx \bar{Z} \text{)}$$

Модель Старретта и Саумона обеспечивает все необходимые входные величины

1. J. Daligault, G. Dimonte. Phys. Rev. E 79, 056403 (2009).

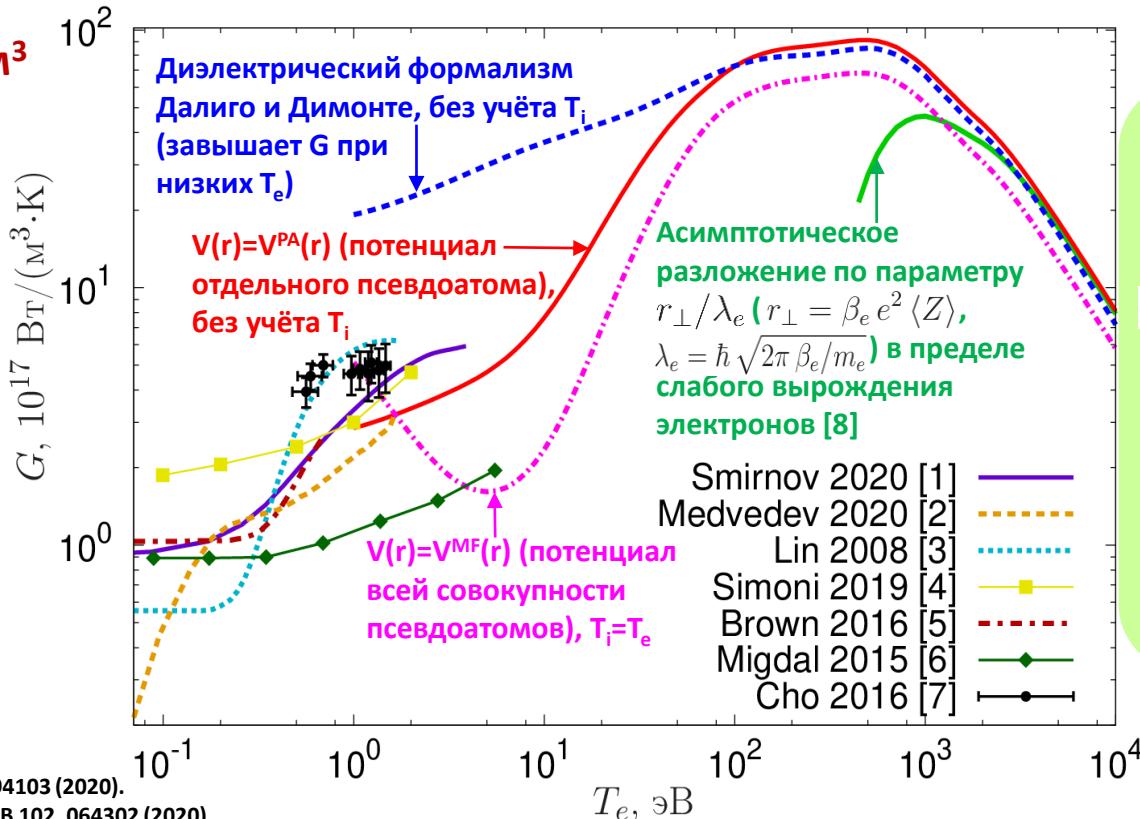
2. S. Ichimaru, K. Utsumi. Phys. Rev. B 24, 7385 – 7388 (1981).

3. G. Chabrier. J. Phys. France 51, 1607 – 1632 (1990).

Коэффициент электрон-ионного/электрон-фононного обмена в меди

$\rho=8.92 \text{ г/см}^3$

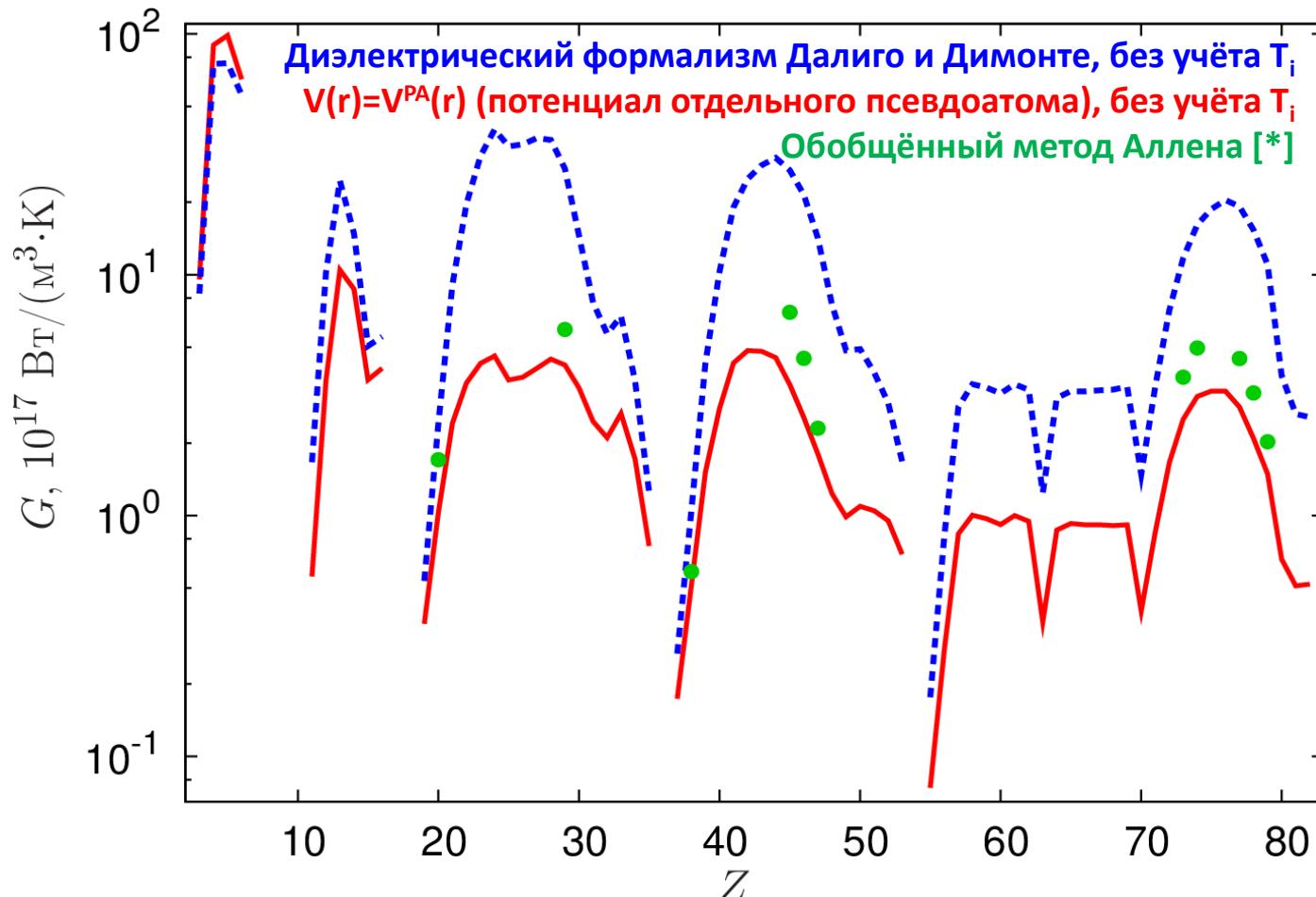
Сравнение с результатами многоцентровых расчётов не позволяет однозначно отдать предпочтение $V^{\text{PA}}(r)$ или $V^{\text{MF}}(r)$



$V^{\text{PA}}(r)$ обеспечивает более точную асимптотику
 $G \propto \ln r_{\text{De}}$ (r_{De} – электронный дебаевский радиус), чем $V^{\text{MF}}(r)$
 $(G \propto \ln r_D$, r_D – полный дебаевский радиус)

1. N.A. Smirnov. Phys. Rev. B 101, 094103 (2020).
2. N. Medvedev, I. Milov. Phys. Rev. B 102, 064302 (2020).
3. Z. Lin, L.V. Zhigilei, V. Celli. Phys. Rev. B 77, 075133 (2008).
4. J. Simoni, J. Daligault. Phys. Rev. Lett. 122, 205001 (2019).
5. A.M. Brown, R. Sundararaman, P. Narang, W.A. Goddard, H.A. Atwater. Phys. Rev. B 94, 075120 (2016).
6. K.P. Migdal, D.K. Il'nitsky, Yu.V. Petrov, N.A. Inogamov. J. Phys.: Conf. Ser. 653, 012086 (2015).
7. B.I. Cho, T. Ogitsu, K. Engelhorn *et al.* Sci. Rep. 6, 18843 (2016).
8. L.S. Brown, R.L. Singleton. Phys. Rev. E 76, 066404 (2007).

Зависимость $G(Z)$ при $\rho=\rho_0$, $T_e=45$ кК (3.88 эВ)



Открытые вопросы



- Какой рассеивающий потенциал следует использовать в расчётах коэффициента электрон-ионного обмена и электропроводности/теплопроводности на основе моделей среднего атома?
- Как выйти за рамки приближения однородного электронного газа и/или как правильно определить средний заряд иона в формуле Займана?
- Качественная и количественная зависимость коэффициента электрон-ионного/электрон-фононного обмена от температуры ионов.

Выводы

- Показано, что разработанные Алленом методы расчёта коэффициента электрон-фононного обмена и электропроводности в частном случае сферического электронного потенциала согласуются с методами, которые были развиты применительно к моделям среднего атома. При этом транспортное сечение рассеяния электрона в потенциале среднего атома при расчёте электропроводности должно вычисляться с учётом ионного структурного фактора, а при расчёте коэффициента электрон-ионного обмена – без учёта структурного фактора.

Выводы

- Применительно к расчётом коэффициента электрон-ионного обмена протестированы два способа вычисления рассеивающего потенциала на основе модели среднего атома Старретта и Саумона. Показано, что оба способа дают в целом близкую степень согласия с результатами многоцентровых расчётов при температурах электронов порядка нескольких эВ, но при этом расчёт сечения рассеяния в потенциала отдельного псевдоатома обеспечивает более точную высокотемпературную асимптотику по сравнению с потенциалом, создаваемым всей совокупностью псевдоатомов. Альтернативный способ расчёта коэффициента электрон-ионного обмена при помощи диэлектрического формализма Далиго и Димонте, адаптированного к модели Старретта и Саумона, систематически завышает результаты при $T_e < 10 - 100$ эВ.